

2SA956

2SA956

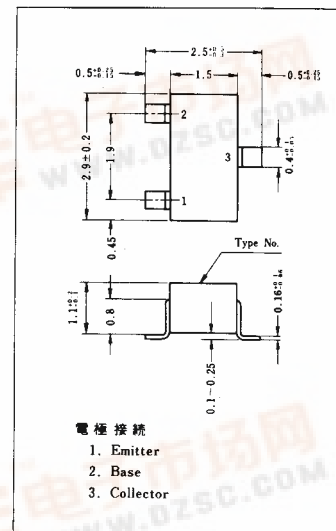
PNP エピタキシャル形シリコントランジスタ / PNP SILICON EPITAXIAL TRANSISTOR

高周波増幅, 中速度スイッチング用 / High Frequency Amplifier, Medium Speed Switching
通信工業用 / Industrial Use

特 徴 / FEATURES

- ・超小形パッケージを採用しており, ハイブリッドIC用として最適。
Very small size to assure good space factor in hybrid IC applications.
- ・高周波増幅はもとより, スイッチング, 低周波増幅など広範囲な回路に使用できます。
Suitable for switching and audio amplifier as well as high frequency amplifier.
- ・耐圧が高く, 電源電圧の変動に対して余裕がある。
Keeps stabilized operation against power voltage fluctuation.
 $V_{CEO} > -40V, V_{EBO} > -8V$
- ・直流電流増幅率が高く, 直線性が優れている。
High DC current gain and excellent linearity.
 $h_{FE}(I_C = -10mA) : 160TYP.$

外形図 / PACKAGE DIMENSIONS (Unit:mm)



絶対最大定格 / ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (T_a = 25°C)

項 目	略 号	定 格	単 位
コレクタ・ベース間電圧	V _{CB0}	-60	V
コレクタ・エミッタ間電圧	V _{CEO}	-40	V
エミッタ・ベース間電圧	V _{EBO}	-8.0	V
コレクタ電流	I _C	-100	mA
全損失	P _T	150	mW
ジャンクション温度	T _j	125	°C
保存温度	T _{stg}	-55 ~ +125	°C

電気的特性 / ELECTRICAL CHARACTERISTICS (T_a = 25°C)

項 目	略 号	条 件	MIN.	TYP.	MAX.	単 位
コレクタシャ断電流	I _{CB0}	V _{CB} = -40V, I _E = 0			-100	nA
エミッタシャ断電流	I _{EBO}	V _{EB} = -5.0V, I _C = 0			-100	nA
直流電流増幅率	h _{FE1}	V _{CE} = -1.0V, I _C = -1.0mA	50	155		
直流電流増幅率	h _{FE2}	V _{CE} = -1.0V, I _C = -10mA	80	160	320	
コレクタ飽和電圧	V _{CE(sat)}	I _C = -10mA, I _B = -1.0mA		-0.06	-0.3	V
ベース飽和電圧	V _{BE(sat)}	I _C = -10mA, I _B = -1.0mA		-0.75	-1.0	V
利得帯域幅積	f _T	V _{CE} = -10V, I _E = 10mA	150	280		MHz
コレクタ容量	C _{ob}	V _{CB} = -10V, I _E = 0, f = 1.0MHz		7.5	10	pF
ターンオン時間	t _{on}	測定回路図参照 / See test circuit		100		ns
蓄積時間	t _{stg}			200		ns
ターンオフ時間	t _{off}			270		ns

h_{FE2} 区分 / h_{FE2} Classification

H3 : 80~130 H4 : 110~170 H5 : 150~240 H6 : 200~320